

PLANNING SALLE BLANCHE 2020

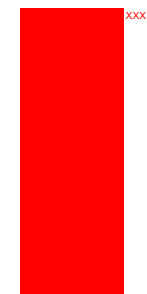


mai 07 juillet 2020

JUILLET 2020					AOUT 2020					SEPTEMBRE 2020				
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	N@S PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	N@S PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	N@S PTA
1 M	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S1/4			1 S					1 M	EXYTE	CHANGEMENTS FFU		
1 AM	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S2/4			1 AM					1 AM	EXYTE	CHANGEMENTS FFU		
2 J					2 D					2 M	EXYTE	CHANGEMENTS FFU	TESTS SSI	
2 AM					2 AM					2 AM	EXYTE	CHANGEMENTS FFU	TESTS SSI	
3 V	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S3/4			3 L					3 J	EXYTE	CHANGEMENTS FFU		
3 AM	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S4/4			3 AM					3 AM	EXYTE	CHANGEMENTS FFU		
4 S					4 M					4 V				
4 AM					4 AM					4 AM				
5 D					5 M					5 S				
5 AM					5 AM					5 AM				
6 L	FC Q. RAFHAY				6 J					6 D				
6 AM					6 AM					6 AM				
7 M	FC Q. RAFHAY				7 V					7 L	ANALYSES VIB	CTA EXT		
7 AM	FC Q. RAFHAY				7 AM					7 AM	ANALYSES VIB	CTA EXT		
8 M	FC Q. RAFHAY				8 S					8 M	ANALYSES VIB	CTA EXT		
8 AM					8 AM					8 AM	ANALYSES VIB	CTA EXT		
9 J					9 D					9 M				
9 AM					9 AM					9 AM				
10 V					10 L					10 J	MASTER WICS	CAPA-DIODE S1/2	1	
10 AM					10 AM					10 AM	MASTER WICS	CAPA-DIODE S2/2	1	
11 S					11 M					11 V				
11 AM					11 AM					11 AM				
12 D					12 M					12 S				
12 AM					12 AM					12 AM				
13 L					13 J					13 D				
13 AM					13 AM					13 AM				
14 M					14 V					14 L				
14 AM					14 AM					14 AM				
15 M					15 S					15 M				
15 AM					15 AM					15 AM				
16 J					16 D					16 M				
16 AM					16 AM					16 AM				
17 V					17 L					17 J	MASTER WICS	CAPA-DIODE S1/2	2	
17 AM					17 AM					17 AM	MASTER WICS	CAPA-DIODE S2/2	2	
18 S					18 M					18 V				
18 AM					18 AM					18 AM				
19 D					19 M					19 S				
19 AM					19 AM					19 AM				
20 L					20 J					20 D				
20 AM					20 AM					20 AM				
21 M					21 V					21 L				
21 AM					21 AM					21 AM				
22 M					22 S					22 M	CONTRÔLE	SORBONNES		
22 AM					22 AM					22 AM	CONTRÔLE	SORBONNES		
23 J					23 D					23 M				
23 AM					23 AM					23 AM				
24 V					24 L					24 J				
24 AM					24 AM					24 AM				
25 S					25 M					25 V				
25 AM					25 AM					25 AM				
26 D					26 M					26 S				
26 AM					26 AM					26 AM				
27 L					27 J	ESONN	MEMS S1/4 MOSTEC S1/4	MEMS1 SD1		27 D				
27 AM					27 AM	ESONN	MEMS S2/4 MOSTEC S2/4	MEMS1 SD1		27 AM				
28 M					28 V	ESONN	MEMS S1/4 MOSTEC S1/4	MEMS2 SD2		28 L				
28 AM					28 AM	ESONN	MEMS S2/4 MOSTEC S2/4	MEMS2 SD2		28 AM				
29 M					29 S					29 M	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S1/2 TP PLASMA SUR ICP	1 et 2 A	
29 AM					29 AM					29 AM	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S2/2 TP PLASMA SUR ICP	1 et 2 B	
30 J					30 D					30 M	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S1/2 TP PLASMA SUR ICP	3 et 4 C	
30 AM					30 AM					30 AM	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S2/2 TP PLASMA SUR ICP	3 et 4 D	
31 V					31 L	ESONN	MEMS S3/4	MEMS1						
31 AM					31 AM	ESONN	MEMS S4/4	MEMS1						

légende	salle blanche	équipements utilisés									
séances TP	et	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
		équipements utilisés									
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/4	photolithographie S1x + RIE										
MOSTEC S3/4	implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										
		équipements utilisés									
MEMS S1/4	photolithogravure Si poly										
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit										
MEMS S3/4	alu+SOL-PR+BOE FAR+ litho+etch										
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE										
		équipements utilisés									
CAPA-DIODE S1/2	nett+dryox+dopage+litho+gravure										
CAPA-DIODE S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
		équipements utilisés									
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/5	photolithographie S1x + RIE										
MOSTEC S3/5	dopage / implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts										
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al										
		équipements utilisés									
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+nett+wetox										
biopuce S2	hydroxylation										
		équipements utilisés									
CAPA S1/2	nett + DRYox										
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
		équipements utilisés									
high tech U S1/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
high tech U S2/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
		équipements utilisés									
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diffPph										
PV S2/4	désox, nettoyage, dépôt Al										
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho										
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off										
		équipements utilisés									
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA + implantation										
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx.TTh										
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts										
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										

code couleur	
PROGRAMME DE DECOUVERTE	formation continue
OUVERTURE AU PLUBLIC OU LYCEENS	FC prgm européens
FERMETURE	inventaire
we et jour férié	interruption pédagogique
MOSSES RESTREINT OU INTERDIT	F1
pont	libre
à confirmer	travaux/contrôles



PLANNING CARACTERISATION ELECTRIQUE 2020												
JUILLET 2020				AOUT 2020				SEPTEMBRE 2020				
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	
1	M	M		1	S	M		1	M	M		
	AM				AM				AM			
2	J	M		2	D	M		2	M	M		
	AM				AM				AM			
3	V	M		3	L	M		3	J	M		
	AM				AM				AM			
4	S	M		4	M	M		4	V	M		
	AM				AM				AM			
5	D	M		5	M	M		5	S	M		
	AM				AM				AM			
6	L	M		6	J	M		6	D	M		
	AM				AM				AM			
7	M	M		7	V	M		7	L	M		
	AM				AM				AM			
8	M	M	FC Q. RAFHAY	8	S	M		8	M	M		
	AM				AM				AM			
9	J	M		9	D	M		9	M	M		
	AM				AM				AM			
10	V	M		10	L	M		10	J	M		
	AM				AM				AM			
11	S	M		11	M	M		11	V	M		
	AM				AM				AM			
12	D	M		12	M	M		12	S	M		
	AM				AM				AM			
13	L	M		13	J	M		13	D	M		
	AM				AM				AM			
14	M	M		14	V	M		14	L	M		
	AM				AM				AM			
15	M	M		15	S	M		15	M	M		
	AM				AM				AM			
16	J	M		16	D	M		16	M	M		
	AM				AM				AM			
17	V	M		17	L	M		17	J	M		
	AM				AM				AM			
18	S	M		18	M	M		18	V	M		
	AM				AM				AM			
19	D	M		19	M	M		19	S	M		
	AM				AM				AM			
20	L	M		20	J	M		20	D	M		
	AM				AM				AM			
21	M	M		21	V	M		21	L	M		
	AM				AM				AM			
22	M	M		22	S	M		22	M	M		
	AM				AM				AM			
23	J	M		23	D	M		23	M	M		
	AM				AM				AM			
24	V	M		24	L	M		24	J	M		
	AM				AM				AM			
25	S	M		25	M	M		25	V	M		
	AM				AM				AM			
26	D	M		26	M	M		26	S	M		
	AM				AM				AM			
27	L	M		27	J	M		27	D	M		
	AM				AM				AM			
28	M	M		28	V	M		28	L	M		
	AM				AM				AM			
29	M	M		29	S	M		29	M	M		
	AM				AM				AM			
30	J	M		30	D	M		30	M	M		
	AM				AM				AM			
31	V	M		31	L	M						
	AM				AM							

séances TP		légende										
		salle blanche					et équipements utilisés					
		chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo		
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox											
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE											
MOSTEC S3/4	implant+nett+recuit											
MOSTEC S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al											
MEMS S1/4	photolithogravure Si poly											
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit											
MEMS S3/4	alu+SOI-PR-BOE FAR+ litho+etch											
MEMS S4/4	back side alignmnet + DRIE											
CAPA-DIODE S1/2	nett+dryox+dopage+litho+gravure											
CAPA-DIODE S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu											
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox											
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE											
MOSTEC S3/5	dopage / implant+nett+recuit											
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts											
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al											
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+nett+wetox											
biopuce S2	hydroxylation											
CAPA S1/2	nett + DRYox											
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu											
high tech U S1/2	LITHO avec 2'22 groupes 1h + 1 gp IMEP											
high tech U S2/2	LITHO avec 2'22 groupes 1h + 1 gp IMEP											
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diffPh											
PV S2/4	désox, nettoyage, dépôt Al											
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho											
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off											
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA + implantation											
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx TTh											
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts											
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al											

code couleur	
PROGRAMME DE DECOUVERTE	formation continue
OUVERTURE AU PUBLIC OU LYCEENS	FC pigm européens
FERMETURE	inventaire
we et jour féré	interruption pédagogique
ACCES RESTREINT OU INTERDIT	FI
point	libre
à confirmer	travaux/contrôles



PLANNING SALLE BLANCHE 2021														
OCTOBRE 2020				NOVEMBRE 2020				DECEMBRE 2020				NGS PTA		
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr			
1	J M			1	D M	TOUSSAINT		1	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S1/4	7 ET 8		
	AM				AM				AM					
2	V M	INSA SEI	MOSTEC S1/4	1 et 2	2	L M	INSA SEI	MOSTEC S3/4	1 et 2	2	M M	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S1/4	1 et 2
	AM	INSA SEI	MOSTEC S2/4	1 et 2		AM	INSA SEI	MOSTEC S4/4	1 et 2		AM	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S2/4	1 et 2
3	S M			3	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S1/4	3 et 4	3	J M	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S1/4	3 et 4	
	AM				AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S2/4	3 et 4		AM	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S2/4	3 et 4	
4	D M			4	M M	ENSE3 M2 smart gnd	CAPA-DIODE S1/2	1 et 2	4	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S3/4	2	
	AM				AM	ENSE3 M2 smart gnd	CAPA-DIODE S2/2	1 et 2		AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	4	
6	L M	arrêt technique		5	J M	ENSE3 M2 smart gnd	CAPA-DIODE S1/2	3	5	S M				
	AM	arrêt technique			AM	ENSE3 M2 smart gnd	CAPA-DIODE S2/2	3		AM				
6	M M	arrêt technique		6	V M	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	2 gps	6	D M				
	AM	arrêt technique			AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S2/2	2 gps		AM				
7	M M			7	S M				7	L M	INSA SEI	MOSTEC S3/4	3 et 4	
	AM				AM					AM	INSA SEI	MOSTEC S4/4	3 et 4	
8	J M	mise à blanc	accès interdit	8	D M				8	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S3/4	7 ET 8	
	AM	mise à blanc	accès interdit		AM					AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S4/4	7 ET 8	
9	V M	mise à blanc	accès interdit	9	L M	IUT LPRO MEMO	MOSTEC S1/4	1 et 2	9	M M	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S3/4	1 et 2	
	AM	mise à blanc	accès interdit		AM	IUT LPRO MEMO	MOSTEC S2/4	1 et 2		AM	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S4/4	1 et 2	
10	S M			10	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S3/4	3 et 4	10	J M	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S3/4	3 et 4	
	AM				AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S4/4	3 et 4		AM	PHELMA SIM_FAME 3A	PV S4/4	3 et 4	
11	D M			11	M M	ARMISTICE			11	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S1/4	3	
	AM				AM					AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	5	
12	L M			12	J M	IUT LPRO MEMO	MOSTEC S3/4	1 et 2	12	S M				
	AM				AM	IUT LPRO MEMO	MOSTEC S4/4	1 et 2		AM				
13	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S1/4	1 et 2	13	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S1/4	1	13	D M			
	AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S2/4	1 et 2		AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	1		AM			
14	M M	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S1/2	5 ET 6	14	S M			14	L M				
	AM	POLYTECH GRE MATS	TP PLASMA SUR ICP	E		AM				AM				
15	J M	MASTER WICS	CAPA-DIODE S1/2	7 et 8	15	D M			15	M M				
	AM	MASTER WICS	CAPA-DIODE S2/2	7 et 8		AM				AM				
16	V M	POLYTECH GRE MATS	CAPA-DIODE S1/2	7 et 8	16	L M	IUT LPRO MEMO	MOSTEC OU PHOTOLUM	3 ET 4	16	M M	UCBL SIDS	CHAPRON S1/4	2
	AM	POLYTECH GRE MATS	TP PLASMA SUR ICP	G		AM	IUT LPRO MEMO	MOSTEC OU PHOTOLUM	3 et 4		AM	UCBL SIDS	CHAPRON S2/4	2
17	S M	début vacances scolaires		17	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S1/4	5 ET 6	17	J M	UCBL SIDS	CHAPRON S1/4	3	
	AM				AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S2/4	5 ET 6		AM	UCBL SIDS	CHAPRON S2/4	3	
18	D M			18	M M	Polytech Gre IESE5	CAPA-DIODE S1/2	2 gps	18	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S3/4	3	
	AM				AM	polytech Gre IESE5	CAPA-DIODE S2/2	2 gps		AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	6	
19	L M			19	J M	IUT LPRO MEMO	photolum evap et	3 et 4	19	S M				
	AM				AM	IUT LPRO MEMO	photo lithographie	3 et 4		AM				
20	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S3/4	3 et 4	20	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S3/4	1	20	D M			
	AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S4/4	3 et 4		AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	2		AM			
21	M M			21	S M				21	L M				
	AM				AM					AM				
22	J M	MASTER WICS	CAPA-DIODE S1/2	5 ET 6	22	D M			22	M M				
	AM	MASTER WICS	CAPA-DIODE S2/2	5 ET 6		AM				AM				
23	V M			23	L M				23	M M				
	AM				AM					AM				
24	S M			24	M M	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S3/4	5 ET 6	24	J M				
	AM				AM	Iphy (PNS) 2A	MOSTEC S4/4	5 ET 6		AM				
25	D M			25	M M				25	V M	Noël			
	AM				AM					AM				
26	L M			26	J M				26	S M				
	AM				AM					AM				
27	M M			27	V M	INSA LYON SGM	CHAPRON S1/4	2	27	D M				
	AM				AM	UGA Master Nano1	CAPA-DIODE S1/2	3		AM				
28	M M			28	S M				28	L M				
	AM				AM					AM				
29	J M			29	D M				29	M M				
	AM				AM					AM				
30	V M			30	L M	INSA SEI	MOSTEC S1/4	3 et 4	30	M M				
	AM				AM	INSA SEI	MOSTEC S2/4	3 et 4		AM				
31	S M			31	J M				31	J M				
	AM				AM					AM				

salle blanche		légende												
		séances TP et équipements utilisés												
		équipements utilisés chimie four ox litho RIE four recuit PVD four dopage diff P ellipso proflo												
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox													
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE													
MOSTEC S3/4	implant+net+recuit													
MOSTEC S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al													
MEMS S1/4	photolithographie Si poly													
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit													
MEMS S3/4	alu+SOI-PR+BOE FAR +litho+etch													
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE													
CAPA-DIODE S1/2	net+dryox+dopage+litho+gravure													
CAPA-DIODE S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu													
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox													
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE													
MOSTEC S3/5	dopage / implant+net+recuit													
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts													
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al													
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+net+wetox													
biopuce S2	hydroxylation													
CAPA S1/2	net+ DRYOX													
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu													
high tech U S1/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP													
high tech U S2/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP													
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diffPh													
PV S2/4	désox, nettoyage, dépôt Al													
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho													
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off													
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA + implantation													
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx Tth													
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts													
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al													

code couleur	
PROGRAMME DE DECOUVERTE	formation continue
OUVERTURE AU PUBLIC OU LYCEENS	FC prgm européens
FERMETURE	inventaire
we et jour férié	interruption pédagogique
RODES RESTREINT OU INTERDIT	FI
point	libre
à confirmer	travaux/comptes

26-sept-19 modification dates et groupes ENE3 (par Marceline)
28-sept-19 modification pour M1 NanoPhy
10-oct-19 séance en moins du 17/10 M. WICS
ajout séances 20 nov et 20 dec pour X Gre ise5
16/10/2019 annulation séance UGA Master nano1 du 6/12
24/10/2019 modification nbres gps et orga des séances TP PV fame

PLANNING CARACTERISATION ELECTRIQUE 2021

15-juil.-20



OCTOBRE 2021				NOVEMBRE 2020				DECEMBRE 2020			
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr
1	J M AM			1	D M AM	TOUSSAINT		1	M M AM		
2	V M AM			2	L M AM			2	M M AM		
3	S M AM			3	M M AM			3	J M AM		
4	D M AM			4	M M AM			4	V M AM	UGA M1 NANOSCIENCE	
5	L M AM	arrêt technique		5	J M AM			5	S M AM		
6	M M AM	arrêt technique		6	V M AM			6	D M AM		
7	M M AM			7	S M AM			7	L M AM		
8	J M AM			8	D M AM			8	M M AM		
9	V M AM			9	L M AM			9	M M AM		
10	S M AM			10	M M AM			10	J M AM		
11	D M AM			11	M M AM	ARMISTICE		11	V M AM		
12	L M AM			12	J M AM			12	S M AM		
13	M M AM			13	V M AM			13	D M AM		
14	M M AM	POLYTECH GRE MAT5		14	S M AM			14	L M AM		
15	J M AM	POLYTECH GRE MAT5		15	D M AM			15	M M AM		
16	V M AM	POLYTECH GRE MAT5		16	L M AM			16	M M AM		
17	S M AM			17	M M AM			17	J M AM		
18	D M AM			18	M M AM			18	V M AM		
19	L M AM			19	J M AM			19	S M AM		
20	M M AM			20	V M AM			20	D M AM		
21	M M AM			21	S M AM			21	L M AM		
22	J M AM			22	D M AM			22	M M AM		
23	V M AM	POLYTECH GRE MAT5		23	L M AM			23	M M AM		
24	S M AM	POLYTECH GRE MAT5		24	M M AM			24	J M AM		
25	D M AM			25	M M AM			25	V M AM	Noël	
26	L M AM			26	J M AM			26	S M AM		
27	M M AM			27	V M AM	UGA M1 NANOSCIENCE		27	D M AM		
28	M M AM			28	S M AM			28	L M AM		
29	J M AM			29	D M AM			29	M M AM		
30	V M AM			30	L M AM			30	M M AM		
31	S M AM			31	L M AM			31	J M AM		

PLANNING SALLE BLANCHE 2021

maj 03/08/2020



JANVIER 2021					FEBVRIER 2021					MARS 2021				
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NBS PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NBS PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NBS PTA
1	V AM				1	L M	Strasbourg	MOSTEC S1/4	1 et 2	1	L M	UCBL ALT L RENAUD		
2	S M				2	M M	Strasbourg	MOSTEC S2/4	1 et 2	2	M M	UCBL ALT L RENAUD		
3	D M				3	M M	Strasbourg	MOSTEC S3/4	1 et 2	3	M M	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	3 et 4
4	L M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S1/4	1 et 2	4	J M	Strasbourg	MOSTEC S4/4	1 et 2	4	J M	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S2/2	3 et 4
5	M M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S2/4	1 et 2	5	V M	M. MISTRE	MOSTEC S1/4	3 et 4	5	V M	UCBL ALT L RENAUD		
6	M M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S3/4	1 et 2	6	S M				6	S M	PHELMA BIO ENG	CAPA-DIODE S1/2	3 et 4
7	J M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S4/4	1 et 2	7	D M				7	D M	PHELMA BIO ENG	CAPA-DIODE S2/2	3 et 4
8	V M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S1/4	1 et 2	8	L M				8	L M			
9	S M				9	M M				9	M M			
10	D M				10	M M				10	M M			
11	L M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S1/4	3 et 4	11	J M				11	J M			
12	M M	PHELMA APPRENTIS	MOSTEC S2/4	3 et 4	12	V M				12	V M			
13	M M				13	S M				13	S M			
14	J M				14	D M				14	D M			
15	V M				15	L M				15	L M			
16	S M				16	M M				16	M M			
17	D M				17	M M				17	M M			
18	L M				18	J M				18	J M			
19	M M				19	V M				19	V M			
20	M M				20	S M				20	S M			
21	J M				21	D M				21	D M			
22	V M				22	L M				22	L M			
23	S M				23	M M				23	M M			
24	D M				24	M M				24	M M			
25	L M				25	J M				25	J M			
26	M M				26	V M				26	V M			
27	M M				27	S M				27	S M			
28	J M				28	D M				28	D M			
29	V M				29	L M				29	L M			
30	S M				30	M M				30	M M			
31	D M				31	M M				31	M M			

salle blanche		légende										
		séances			TP			et équipements utilisés				
		chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo		
équipements utilisés												
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox											
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE											
MOSTEC S3/4	implant+net+recuit											
MOSTEC S4/4	dépot + photolitho +gravure Al											
équipements utilisés												
MEMS S1/4	photolithographe Si poly											
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit											
MEMS S3/4	alu+SOI-PR+BOE FAR+ litho+etch											
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE											
équipements utilisés												
CAPA-DIODE S1/2	net+dryox+dopage+litho+gravure											
CAPA-DIODE S2/2	dépot + photolitho +gravure alu											
équipements utilisés												
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox											
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE											
MOSTEC S3/5	dopage / implant+net+recuit											
MOSTEC S4/5	dépot LTO et ouverture contacts											
MOSTEC S5/5	dépot + photolitho +gravure Al											
équipements utilisés												
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+net+welox											
biopuce S2	hydroxylation											
équipements utilisés												
CAPA S1/2	net + DRY ox											
CAPA S2/2	dépot + photolitho +gravure alu											
équipements utilisés												
high tech U S1/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP											
high tech U S2/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP											
équipements utilisés												
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diffPh											
PV S2/4	désox. nettoyage. dépôt Al											
PV S3/4	RTA. dépôt SiN. photolitho											
PV S4/4	BOE. dépôt alu. lift off											
équipements utilisés												
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA = implantation											
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx TTh											
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts											
CHAPRON S4/4	dépot + photolitho +gravure Al											

Code couleur	
PROGRAMME DE DECOUVERTE	formation continue
OUVERTURE AU PUBLIC OU LYCEENS	FC prgm européens
FERMETURE	inventaire
we et jour férié	interruption pédagogique
ACCES RESTREINT OU INTERDIT	FI
pont	libre
à confirmer	travaux/contrôles

11/09/2019 M. NANOTECH: 10 gps au lieu de 12 (ajout des enseignants)
 15/10/2019 ajout séances des IUT MCPC le 16 mars pour 2 gps en +
 28-mars entrain de séances de NBS

PLANNING SALLE BLANCHE 2021

màj 02/09/2020



JANVIER 2021				FEVRIER 2021				MARS 2021			
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr
1	V M AM			1	L M AM			1	L M AM		
2	S M AM			2	M M AM			2	M M AM	PHELMA SEI	
3	D M AM			3	M M AM	STRASBOURG		3	M M AM		
4	L M AM			4	J M AM			4	J M AM		
5	M M AM	FAME 3A (VOLPI)	PV	5	V M AM	STRASBOURG		5	V M AM		
6	M M AM	PHELMA APPRENTIS		6	S M AM			6	S M AM		
7	J M AM			7	D M AM			7	D M AM		
8	V M AM			8	L M AM			8	L M AM		
9	S M AM			9	M M AM			9	M M AM	PNS 2A	
10	D M AM			10	M M AM			10	M M AM	M. NANOTECH	1 et 2
11	L M AM			11	J M AM			11	J M AM	M. NANOTECH	1 et 2
12	M M AM	FAME 3A (VOLPI)	PV	12	V M AM			12	V M AM	IUT CAPA	
13	M M AM	PHELMA APPRENTIS		13	S M AM			13	S M AM	Bio Eng.	
14	J M AM	PHELMA APPRENTIS		14	D M AM			14	D M AM		
15	V M AM			15	L M AM			15	L M AM		
16	S M AM			16	M M AM			16	M M AM	PNS 2A	
17	D M AM			17	M M AM			17	M M AM	PHELMA SEI	
18	L M AM			18	J M AM			18	J M AM		
19	M M AM	FAME 3A (VOLPI)	PV	19	V M AM			19	V M AM	IUT CAPA	
20	M M AM	STRASBOURG		20	S M AM			20	S M AM	bio Eng.	
21	J M AM			21	D M AM			21	D M AM	bio Eng.	
22	V M AM	STRASBOURG		22	L M AM			22	L M AM		
23	S M AM			23	M M AM			23	M M AM	PNS 2A	
24	D M AM			24	M M AM			24	M M AM	PHELMA SEI	
25	L M AM			25	J M AM			25	J M AM	M. NANOTECH	5 et 6
26	M M AM			26	V M AM			26	V M AM	M. NANOTECH	5 et 6
27	M M AM	PHELMA APPRENTIS		27	S M AM			27	S M AM	IUT CAPA	
28	J M AM	PHELMA APPRENTIS		28	D M AM			28	D M AM		
29	V M AM			29	L M AM			29	L M AM		
30	S M AM			30	M M AM			30	M M AM	PNS 2A	
31	D M AM			31	M M AM			31	M M AM	PHELMA SEI	

PLANNING SALLE BLANCHE 2021

mai 16 juillet 2020



AVRIL 2021					MAI 2021					JUIN 2021				
DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NbS PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NbS PTA	DATE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	NbS PTA
1 J M					1 S M	fete du travail				1 M M				
2 V M	UGA M1 Phy RF RI (exPFN)	CAPA-DIODE S1/2	5 et 6		2 D M					2 M M				
3 S M	UGA M1 Phy RF RI (exPFN)	CAPA-DIODE S2/2	5 et 6		3 L M	ENSGI?	CAPA S1/2	1 et 2		3 J M	POLYTECH NICE	MOSTEC S2/4	1 et 2	
4 D M					4 M M	ENSGI?	CAPA S2/2	1 et 2		4 V M	POLYTECH NICE	MOSTEC S4/4	1 et 2	
5 L M					5 M M	M. Nanotech	MEMS S3/4	11+12		5 S M	POLYTECH NICE	MOSTEC S3/4	1 et 2	
6 M M	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	11 et 12		6 J M	IUT1 GRE ALT	CAPA S1/2	3 et 4		6 D M				
7 M M	M. Nanotech	MEMS S1/4	7+8		7 V M					7 L M				
8 J M	M. Nanotech	MEMS S2/4	7+8		8 S M	ARMISTICE				8 M M	IUT ME PHY ST ETIENNE	CAPA-DIODE S1/2	1 et 2	
9 V M	UGA M1 Phy RF RI (exPFN)	CAPA-DIODE S1/2	7+8		9 D M					9 M M	IUT ME PHY ST ETIENNE	CAPA-DIODE S1/2	3 et 4	
10 S M	UGA M1 Phy RF RI (exPFN)	CAPA-DIODE S2/2	7+8		10 L M					10 J M	N@S		1 et 2	
11 D M	Pâques				11 M M					11 V M				
12 L M	lundi de Pâques				12 M M					12 S M				
13 M M					13 J M	Ascension				13 D M				
14 M M	M. Nanotech	MEMS S3/4	7+8		14 V M		6 et 7			14 L M				
15 J M	M. Nanotech	MEMS S1/4	9+10		15 S M					15 M M				
16 V M	M. Nanotech	MEMS S2/4	9+10		16 D M					16 M M	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S1/4		
17 S M	M. Nanotech	MEMS S3/4	9+10		17 L M	ENSGI?	CAPA S1/2	1 et 2		17 J M	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S2/4		
18 D M	M. Nanotech	MEMS S4/4	9+10		18 M M	M. MISTRE	CAPA-DIODE S1/2	1 et 2		18 V M	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S3/4		
19 L M					19 M M	M. MISTRE	CAPA-DIODE S2/2	1 et 2		19 S M	SUMMER PRGM SCHOOL	PV S4/4		
20 M M					20 J M	M2 Nnaoscience/PHITEM / A. MANTOUX	CAPA-DIODE S1/2	2 et 3		20 D M				
21 M M					21 M M	M2 Nnaoscience/PHITEM / A. MANTOUX	CAPA-DIODE S2/2	2 et 3		21 V M				
22 J M					22 J M	IUT1 GRE ALT	CAPA S1/2	5 et 6		22 M M				
23 V M					23 M M	IUT1 GRE ALT	CAPA S2/2	5 et 6		23 D M				
24 S M					24 V M	M. MISTRE	CAPA-DIODE S1/2			24 L M				
25 D M					25 M M	M. MISTRE	CAPA-DIODE S2/2			25 M M				
26 L M					26 M M					26 S M				
27 M M					27 J M					27 D M				
28 M M	M. Nanotech	MEMS S1/4	11+12		28 V M					28 L M				
29 J M	M. Nanotech	MEMS S2/4	11+12		29 S M					29 M M				
30 V M	IUT1 GRE ALT	CAPA S1/2	1 et 2		30 D M					30 M M				
31 M M	IUT1 GRE ALT	CAPA S2/2	1 et 2		31 L M					31 M M				

séances TP		légende	salle blanche et		équipements utilisés						
DATE	FORMATION		chime	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage dff P	alliso	profilo
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/4	implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/4	dépôt+ photolitho +gravure Al										
MEMS S1/4	photolithographie Si poly										
MEMS S2/4	dopage / implantation + recuit										
MEMS S3/4	alu+SOI-PR+BOE FAR+ litho+etch										
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE										
CAPA-DIODE S1/2	nett+dryox+dopage+litho+gravure										
CAPA-DIODE S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/5	dopage / implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts										
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al										
biopuce S1	LithoOX+etch/KOH+nett+wetox										
biopuce S2	hydroxylation										
CAPA S1/2	nett + DRYox										
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
high tech U S1/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
high tech U S2/2	LITHO avec 2'2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+dff Ph										
PV S2/4	désox. nettoyage. dépôt Al										
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho										
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off										
CHAPRON S1/4	ouvertures ZA + implantation										
CHAPRON S2/4	photolitho+grav. Ox. +dryOx.TTh										
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts										
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										

code couleur

PROGRAMME DE DECOUVERTE	formation continue
OUVERTURE AU PUBLIC OU LYCEENS	FC prgm européens
FERMIERES	inventaire
lieu et jour fermés	interruption pédagogique
ACCES RESTREINT OU INTERDIT	FI
pont	libre
à confirmer	travaux/contrôles

11/10/2019 M. NANOTECH: 10 gps au lieu de 12 (retrait séances des 13 et 14mai)
 06-nov modif des résa d'ENSGI; les 4 et 18 mai au lieu des 9 et 16 avr
 14/11/2019 AJOUT de N@S du 25 juin / fiburg
 18/11/2019 décalage IUT St Etienne de mai à juin
 12-4ev modif session N@S
 12-4ev suppression des 2 et 3 juin de X Nice

PLANNING CHARACTERISATION ELECTRIQUE 2021

màj 24/8/2020



AVRIL 2021

MAI 2021

JUIN 2021

AVRIL 2021				MAI 2021				JUIN 2021						
DATE		FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE		FORMATION	TP SEANCE	Gr	DATE		FORMATION	TP SEANCE	Gr
1	J	M			1	S	M	fete du travail		1	M	M		
		AM					AM					AM		
2	V	M			2	D	M			2	M	M		
		AM					AM					AM		
3	S	M			3	L	M			3	J	M		
		AM					AM					AM		
4	D	M			4	M	M	PNS 2A		4	V	M		
		AM					AM					AM		
5	L	M			5	M	M			5	S	M		
		AM					AM	M. NANOTECH	9 et 10			AM		
6	M	M	PNS 2A		6	J	M			6	D	M		
		AM	PHELMA SEI				AM	IUT CAPA				AM		
7	M	M	M. NANOTECH	3 et 4	7	V	M			7	L	M		
		AM	M. NANOTECH	3 et 4			AM					AM		
8	J	M			8	S	M	ARMISTICE		8	M	M		
		AM					AM					AM		
9	V	M			9	D	M			9	M	M		
		AM					AM					AM		
10	S	M			10	L	M			10	J	M		
		AM					AM					AM		
11	D	M	Pâques		11	M	M			11	V	M		
		AM					AM					AM		
12	L	M	lundi de Pâques		12	M	M	M. NANOTECH	11 et 12	12	S	M		
		AM					AM	M. NANOTECH	11 et 12			AM		
13	M	M	PNS 2A		13	J	M			13	D	M		
		AM	PHELMA SEI				AM	Ascension				AM		
14	M	M			14	V	M			14	L	M		
		AM					AM					AM		
15	J	M	M. NANOTECH	7 et 8	15	S	M			15	M	M		
		AM	M. NANOTECH	7 et 8			AM					AM		
16	V	M			16	D	M			16	M	M		
		AM					AM					AM		
17	S	M			17	L	M			17	J	M		
		AM					AM					AM		
18	D	M			18	M	M			18	V	M		
		AM					AM					AM		
19	L	M			19	M	M			19	S	M		
		AM					AM					AM		
20	M	M			20	J	M	IUT CAPA		20	D	M		
		AM					AM					AM		
21	M	M			21	V	M			21	L	M		
		AM					AM					AM		
22	J	M			22	S	M			22	M	M		
		AM					AM					AM		
23	V	M			23	D	M			23	M	M		
		AM					AM					AM		
24	S	M			24	L	M			24	J	M		
		AM					AM					AM		
25	D	M			25	M	M			25	V	M		
		AM					AM					AM		
26	L	M			26	M	M			26	S	M		
		AM					AM					AM		
27	M	M	PNS 2A		27	J	M	IUT LPRO MEMO		27	D	M		
		AM					AM	IUT LPRO MEMO				AM		
28	M	M			28	V	M			28	L	M		
		AM	M. NANOTECH	9 et 10			AM					AM		
29	J	M			29	S	M			29	M	M		
		AM	IUT CAPA				AM					AM		
30	V	M			30	D	M			30	M	M		
		AM					AM					AM		
					31	L	M							
							AM							